

#### 概述

TX4143 是一款内置功率 MOSFET 的单片降压型开关模式转换器。TX4143 在 6-40V 宽输入电源范围内实现 2.5 A 最大输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。

TX4143采用 PWM 电流模工作模式, 环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。

TX4143 外部提供 FS 脚,可通过外接一个电阻设置工作频率。

TX4143 集成了包括逐周期电流限制 和热关断等保护功能。

TX4143 采用 SOP8 封装, 且外围元器件少。

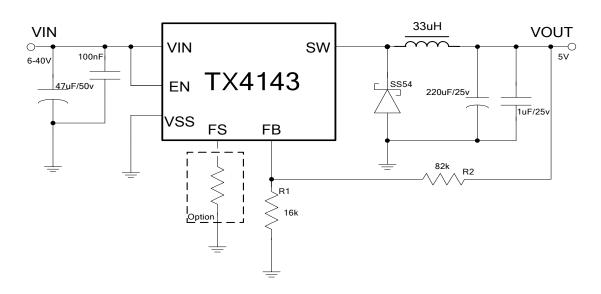
## 特点

- ◆ 2.5A 的最大输出电流
- ◆ 40V/3A 的内部功率 MOSFET
- ◆ 效率高达 93%
- ◆ 频率可调
- ◆ 热关断
- ◆ 逐周期过流保护
- ◆ 宽输入电压范围: 6~40V
- ◆ 采用 SOP8 封装

#### 应用

- ◆ 分布式电源系统
- ◆ 电池充电器
- ◆ 工业电源系统
- ◆ 行车记录仪,车载充电器,扫地机

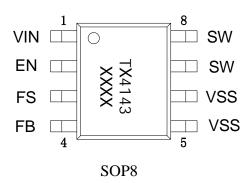
## 典型应用电路图



TX4143\_DS02CN 1 of 9



# 封装及管脚分配



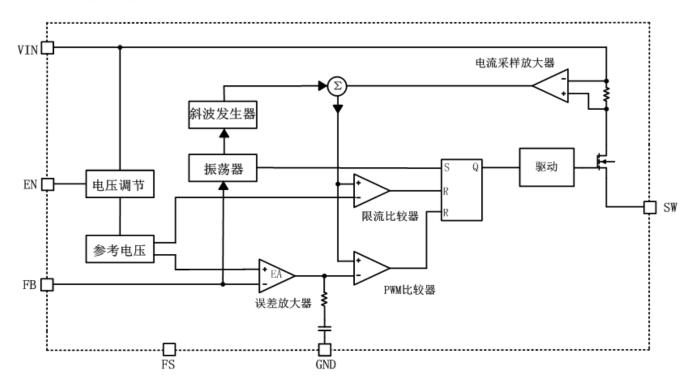
# 管脚定义

管脚号	管脚名	描述		
1	VIN	芯片电源		
2	EN	芯片使能脚		
3	FS	工作频率设置脚		
4	FB	输出反馈电压脚		
5,6	VSS	接地		
7,8	SW	开关输出脚		

TX4143\_DS02CN 2 of 9



## 内部电路方框图



## 极限参数 (注1)

符 号	描述	参数范围	单位
Vin	VIN、EN 脚工作电压范围	-0.3~45	V
Vsw	SW 脚工作电压范围	-0.3~Vin+0.3	V
Vmax	FB、FS 脚工作电压范围	-0.3~6	V
IEN_SINK	EN 脚灌电流	100	μА
$T_{A}$	工作温度范围	-40~85	°C
P <sub>SOP8</sub>	SOP8 封装最大功耗	0.8	W
${ m T_{STG}}$	存储温度范围	-45~150	°C
$T_{\mathrm{SD}}$	焊接温度范围(时间小于30秒)	260	°C
V <sub>ESD</sub>	静电耐压值(人体模型)	2000	V

注 1: 极限参数是指超过上表中规定的工作范围可能会导致器件损坏。而工作在以上极限条件下可能会影响器件的可靠性。

TX4143\_DS02CN 3 of 9



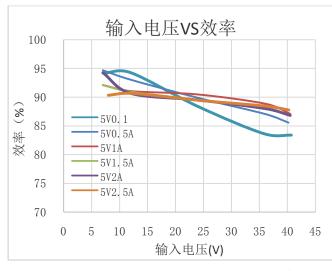
# **电特性**(除非特别说明, V<sub>IN</sub>=12V, T<sub>A</sub>=25°C)

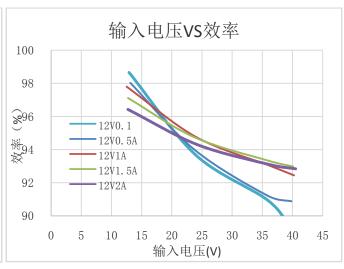
参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位	
反馈电压	$ m V_{FB}$	6V< V <sub>IN</sub> < 40V	0.8	0.82	0.84	V	
反馈电流	IfB	$V_{FB} = 0.85V$			0.1	μА	
开关管漏电流	I <sub>SW_LKG</sub>	$V_{EN} = 0V, \ V_{SW} = 0V$			1	μА	
电流限制阈值	$I_{LIM}$			4.2		A	
任世盟柘安	$ m f_{SW}$	FS 悬空		140		· kHz	
振荡器频率		FS 接 470kΩ 到地		450			
最大占空比	$D_{MAX}$	$V_{FB} = 0.6V$		95		%	
最小打开时间	T <sub>ON</sub>			100		ns	
欠压锁定上升电压	U <sub>UVLO_R</sub>			5.5		V	
欠压锁定迟滞电压	U <sub>UVLO_HYS</sub>			700		mV	
EN 上升阈值	V <sub>EN_R</sub>			1.1		V	
EN下降阈值	V <sub>EN_F</sub>			0.8		V	
EN 迟滞阈值	V <sub>EN_HYS</sub>			300		mV	
EN 绘山由海	I <sub>EN</sub>	V <sub>EN</sub> = 2V		0.1		4	
EN 输出电流		$V_{ ext{E N}} = 0  ext{V}$		0.1		μΑ	
V <sub>IN</sub> 美断电流	$I_S$	$V_{\text{EN}} = 0V$		1		μА	
V <sub>IN</sub> 静态电流	$I_Q$	$V_{EN}\!=2V,\;V_{FB}=1V$		0.15	0.2	mA	
热关断	$T_{SD}$			165		°C	
热关断迟滞	T <sub>SD_HYS</sub>			20		°C	

TX4143\_DS02CN 4 of 9

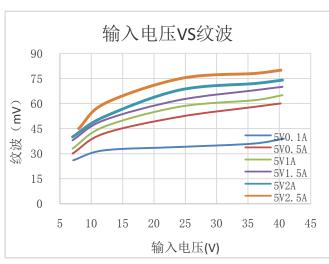


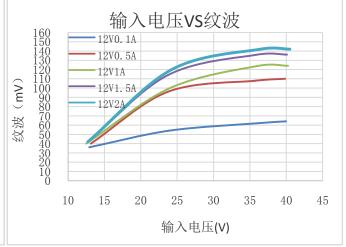
## 典型应用测试特性曲线





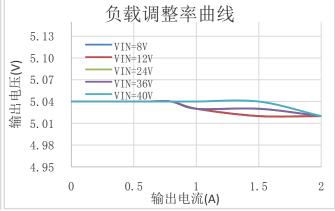
输入电压 VS 效率





输入电压 VS 纹波





EN 关机电流 输出电压 VS 输出电流

TX4143\_DS02CN 5 of 9



#### 应用指南

#### 概述

TX4143 是一款电流模式的降压调节器, EA的输出电压与电感的峰值电流成比例。

在周期开始时,功率管M1关断。EA的输出电压大于电流采样放大器的输出,电流比较器的输出为低,CLK上升沿触发RS触发器置高,打开M1将电感通过SW连接到输入电源。

不断增大的电感电流被电流采样放大器采样并放大。斜波补偿叠加到电流采样放大器输出端,并与EA的输出一起送到PWM比较器进行比较。当叠加了斜波补偿的电流采样放大器输出大于EA输出时,RS触发器被重置并关断M1。电感电流经由外部的肖特基二极管D1续流。

反馈电压FB与 0.82V的基准电压通过EA比较,当FB脚电压低于 0.82V时使EA输出增大。 EA的输出电压正比于电感的峰值电流,EA输出电压增大则输出电流也增大。

TX4143 自带 0.6ms的软启动。软启动防止输出电压在启动阶段过冲。在芯片启动时,内部电路产生一个以固定斜率上升的软启动电压SS,当SS低于内部基准电压时,SS被用来做EA的参考电压,内部基准电压被屏蔽。当SS大于内部基准电压时,内部基准电压控制EA。

#### 输出电压设置

通过连接于FB脚的分压电阻R1,R2设置输出电压。反馈电阻(R2)同时还通过内部补偿网络来设置反馈环路的带宽。R1的取值如下:

$$R1 = \frac{R2}{\frac{\text{Vout}}{0.82V} - 1}$$

下表 1 列出了常用输出电压的电阻取值

Vout (V)	R1 (KΩ)	R2 (KΩ)
1.8	52 (1%)	62 (1%)
2.5	40.2 (1%)	82 (1%)
3.3	27.4 (1%)	82 (1%)
5	16 (1%)	82 (1%)
12	6 (1%)	82 (1%)

### 电感取值

对大多数应用,电感的直流额定电流至少要比最大负载电流大25%。为了达到更高的效率,

TX4143\_DS02CN 6 of 9



电感的直流电阻要小于 200mΩ.电感的取值可有下面的公式计算得到:

$$L = \frac{V_{OUT} \times (V_{IN} - V_{OUT})}{V_{IN} \times \Delta I_{L} \times f_{SW}}$$

其中, ΔΙ, 为电感纹波电流。

电感的纹波电流取值为最大负载电流的30%,电感的最大峰值电流由下面公式计算得到:

$$I_{L \text{ (MAX)}} = I_{LOAD} + \frac{\Delta I_L}{2}$$

轻载模式下(低于100mA),可使用一个大感量值的电感来提高效率。

#### 输入电容的取值

输入电容用来减小输入电源的冲击电流并抑制开关噪声。开关频率下输入电容的容抗要小于输入源的阻抗,可以防止高频开关电流流入输入端。可使用低ESR和低温度系数的电解电容,对大多数应用推荐使用 47μ F电解电容并联 100nF陶瓷电容。对于输入电压较高的应用,输入端电解电容还可以抑制开关机时的输入电压尖峰。

#### 输出电容的取值

输出电容可保持小的输出纹波电压,并保证反馈环路的稳定性。在开关频率下必须保证输出电容的容抗足够小。可使用低ESR的电解电容,对大多数应用来说 220µ F的容值就够用了。

输出并接一个低 ESR 陶瓷电容,可以减小输出纹波,输出稳定。

### 使能控制 EN

使能脚EN用于控制芯片的使能应用,可外加MCU控制,不控制使能的应用,可直接上拉到 VIN脚,不能悬空。

## 工作频率设置 FS

工作频率设置FS用于控制芯片的工作频率,可外接不同的电阻到地,确定不同的工作频率 $f_{SW}$ 。外接电阻 $R_{FS}$ 由下面的公式得到:

$$R_{FS} = \frac{140}{f_{SW} - 140}$$

其中, $f_{SW}$ 为工作频率,单位为KHz,建议 $f_{SW}$ 最大取值 500KHz,典型工作频率 140KHz(FS 脚悬空); $R_{FS}$ 单位为 $M\Omega$  。

TX4143\_DS02CN 7 of 9



#### PCB 布局注意

PCB布局对电路稳定工作很关键。请遵循以下布局指导:

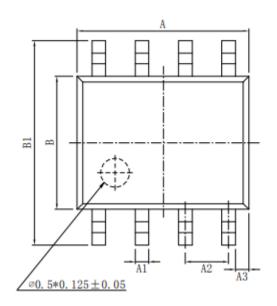
- 1) 保持开关电流通路走线尽可能短并最小化功率环路面积(功率环路由输入电容、MOS和肖特基二极管构成)。
- 2) 功率地 ->肖特基二极管->SW 引脚连接通路应尽可能短和宽。
- 3) 确保反馈电阻靠近芯片,且走线应短。
- 4) SW走线应远离FB反馈信号。
- 5) VIN输入端的 100nF瓷片电容要靠近芯片引脚端。
- 6) VIN, SW, GND 需用大的铜箔连接以改善芯片发热提高长期稳定性。

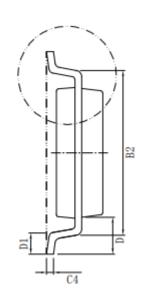
TX4143\_DS02CN 8 of 9

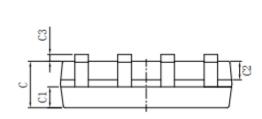


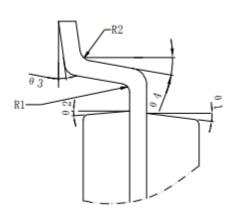
# 封装信息

## SOP8 封装参数









标注	最小(mm)	最大(mm)	标注 尺寸	最小(mm)	最大(mm)
A	4. 80	5. 00	C3	0.05	0. 20
A1	0.356	0. 456	C4	0. 203	0. 233
A2	1. 27TYP		D	1. 05TYP	
A3	0. 345TYP		D1	0.40	0.80
В	3. 80	4.00	R1	0. 20TYP	
B1	5. 80	6. 20	R2	0. 20TYP	
B2	5. 00TYP		θ 1	17° TYP4	
С	1. 30	1. 60	θ 2	13° TYP4	
C1	0. 55	0.65	θ 3	0° ~ 8°	
C2	0.55	0.65	θ 4	4° ′	~ 12°

TX4143\_DS02CN 9 of 9